

SOT223 PNP SILICON PLANAR HIGH VOLTAGE TRANSISTOR

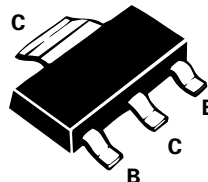
FZT560

ISSUE 1– NOVEMBER 1998

FEATURES

- * 500 Volt V_{CEO}
- * 150mA continuous current
- * $P_{tot} = 2$ Watt

PARTMARKING DETAIL – FZT560



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-500	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-500	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current	I_{CM}	-500	mA
Continuous Collector Current	I_C	-150	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	2	W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

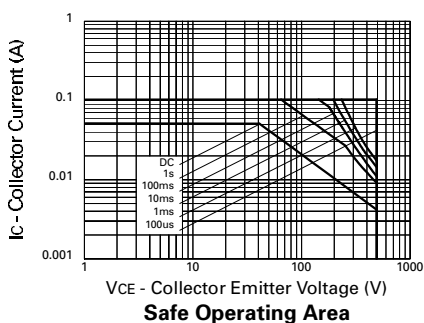
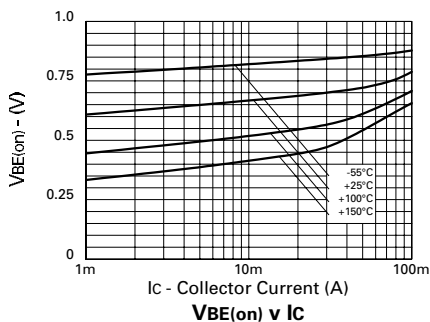
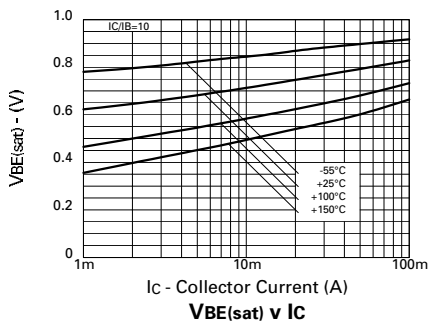
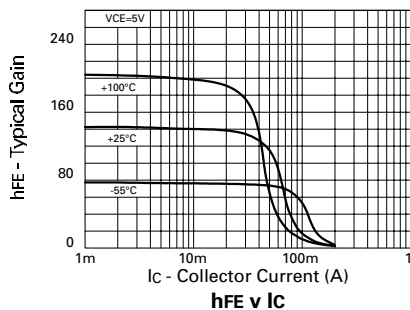
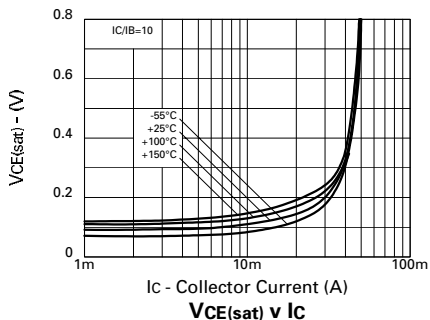
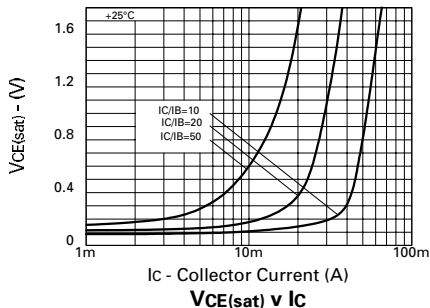
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}C$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-500		V	$I_C = -100\mu A$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{CEO(SUS)}$	-500		V	$I_C = -10mA^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5		V	$I_E = -100\mu A$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		-100	nA	$V_{CB} = -500V$
Collector Cut-Off Current	I_{CES}		-100	nA	$V_{CE} = -500V$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		-100	nA	$V_{EB} = -5V$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-0.20 -0.5	V V	$I_C = -20mA, I_B = -2mA$ $I_C = -50mA, I_B = -10mA^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-0.9	V	$I_C = -50mA, I_B = -10mA^*$
Base-Emitter Turn On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.9	V	$I_C = -50mA, V_{CE} = -10V^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	100 80 15 typ	300 300		$I_C = -1mA, V_{CE} = -10V$ $I_C = -50mA, V_{CE} = -10V^*$ $I_C = -100mA, V_{CE} = -10V^*$
Transition Frequency	f_T	60		MHz	$I_C = -10mA, V_{CE} = -20V$ $f = 50MHz$
Output Capacitance	C_{obo}		8	pF	$V_{CB} = -20, f = 1MHz$
Switching times	t_{on} t_{off}	110 typ. 1.5 typ		ns μs	$V_{CE} = -100, I_C = -50mA,$ $I_{B1} = -5mA, I_{B2} = 10mA,$

* Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

FZT560

TYPICAL CHARACTERISTICS



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9